

シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形トランジスタ  
 SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR (TENTATIVE)

2SC982

- プリンタードライブ, コアドライブ, LEDドライブ用 ○低周波増幅用  
 ○ Printer Drive, Core Drive and LED Drive Applications  
 ○ Low Frequency Amplifier Application

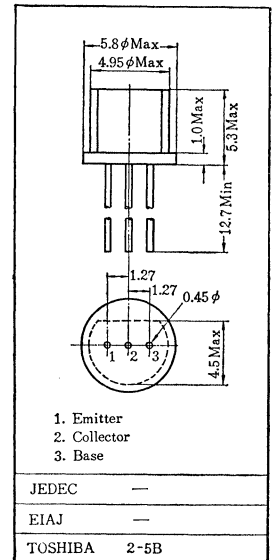
通信工業用  
 Industrial Applications

Unit in mm

- 直流電流増幅率が高い:  $h_{FE(1)}=5000(\text{Min.}) (I_C=10\text{mA})$   
 $h_{FE(2)}=10000(\text{Min.}) (I_C=100\text{mA})$

最大定格 Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

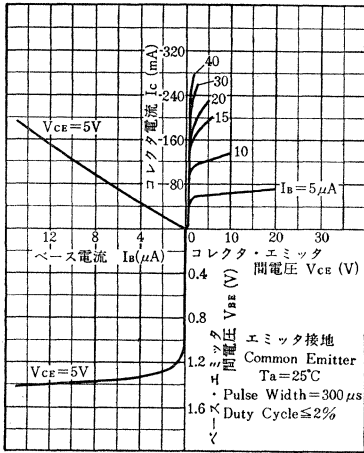
Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$	30	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	10	V
コレクタ電流	$I_C$	300	mA
エミッタ電流	$I_E$	-300	mA
コレクタ損失	$P_C$	300	mW
接合部温度	$T_J$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~125	$^\circ\text{C}$



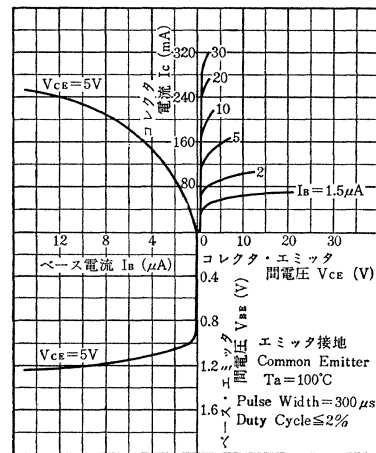
電気的特性 Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Characteristic	Symbol	Test condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
	$I_{CES}$	$V_{CE}=30\text{V}, I_E=0$	—	—	100	
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	5000	—	—	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=100\text{mA}$	10000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=0.1\text{mA}$	—	0.8	1.2	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=100\text{mA}$	—	1.25	1.6	V

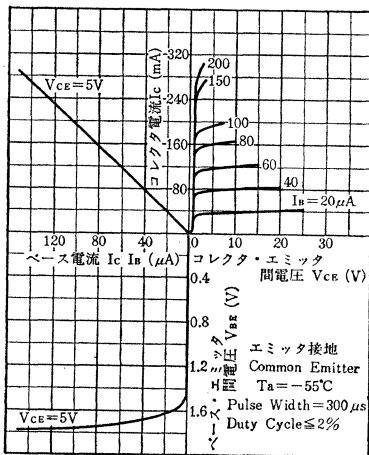
Static Characteristics



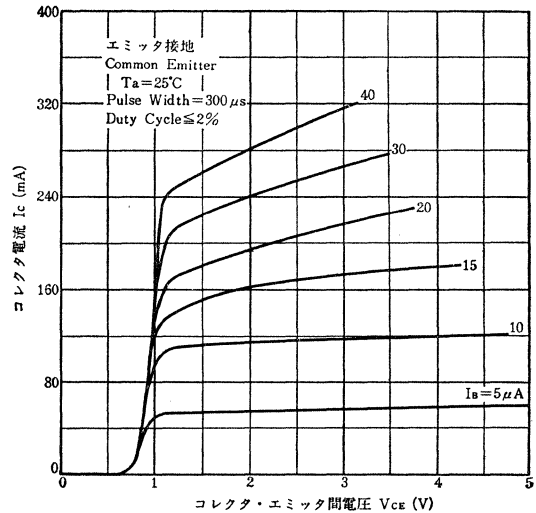
Static Characteristics



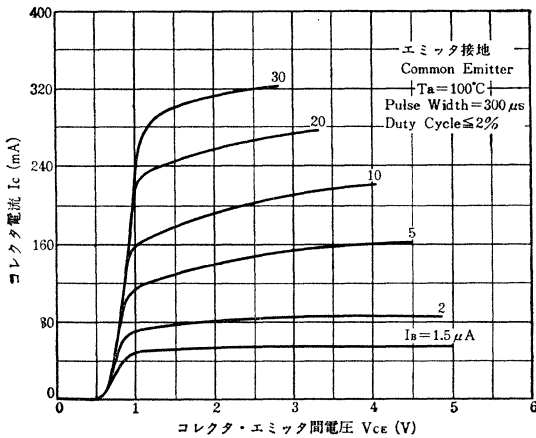
Static Characteristics



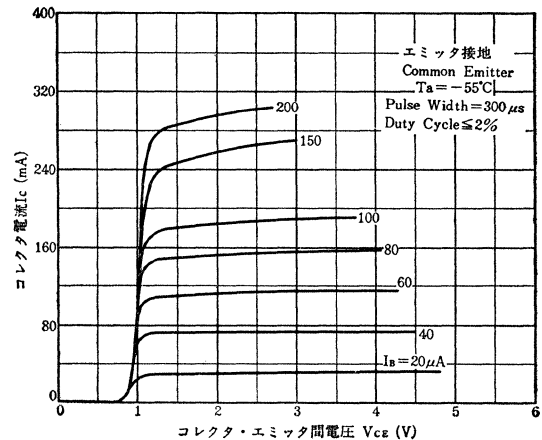
Ic-Vce (Low Voltage Region)



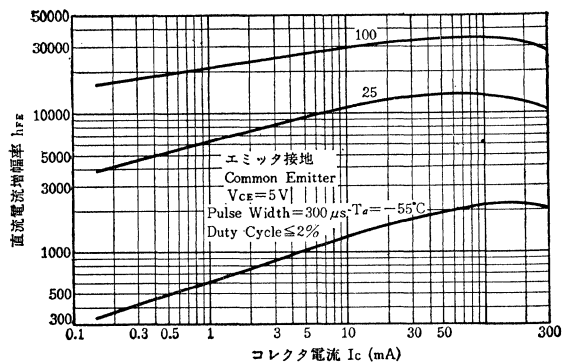
Ic-Vce (Low Voltage Region)



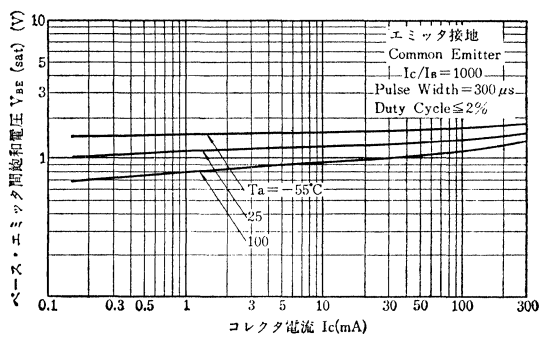
Ic-Vce (Low Voltage Region)



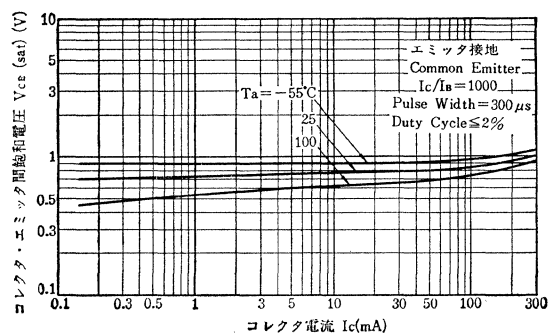
$h_{FE}-I_C$



$V_{BE} (sat)-I_C$



$V_{CE} (sat)-I_C$



$P_C-T_a$

